查询TD131N06KOF供应商

# **6.1E D** ■ 3403257 0001058 917 ■ UPEC 捷多邦,专业PCB打样工厂,24小时加急出货

# TT 131 N, TD 131 N, DT 131 N

löchstzulässige Werte	Maximum rated values					
Periodische Vorwärts- und	repetitive peak forward off-state	$t_{vj} = -40$ °C $t_{vj \text{ max}}$	V <sub>DRM</sub> , V <sub>RRM</sub>		800	V
Rückwärts-S <mark>pitzenspe</mark> rrs <mark>pannu</mark> ng	and reverse voltages			1000,		٧
					1400	V
Vorwärts-Stoßspitzenspannung	non repetitive peak	$t_{vj} = -40^{\circ}C \dots t_{vj \text{ max}}$	$V_{DSM} = V_{DRM}$			
D	forward off-state voltage		V V	0.7	- 100	V
Rückwärts-Stoßspitzenspannung	non repetitive peak reverse voltage	t <sub>vj</sub> = + 25°Ct <sub>vj max</sub>	$V_{RSM} = V_{RRM}$	-	100	٧
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current		ITRMSM		220	Α
Dauergrenzstrom	average on-state current	t <sub>C</sub> = 85°C	TAVM		131	Α
2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		t <sub>C</sub> = 81°C			140	Α
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_{vi} = 25^{\circ}\text{C}, t_{p} = 10 \text{ ms}$	ITSM		3600	Α
	∫i²dt-value	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$			3200	Α
Grenzlastintegral	∫i²dt-value	$t_{vj} = 25^{\circ}C$ , $t_p = 10 \text{ ms}$	∫i² <b>dt</b>	(	64800	A <sup>2</sup> s
	MAN	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$		5	51200	A <sup>2</sup> s
Kritische Str <mark>omsteilhei</mark> t	critical rate of rise of on-state current	$V_D \le 67\% V_{DRM}, f_0 = 50 \text{ Hz}$	(di/dt) <sub>cr</sub>		150	A/μs
Kritische Spannungssteilheit	critical rate of rise of off-state voltage	$v_L = 10 \text{ V}, i_{GM} = 0.6 \text{ A}, di_G/dt = 0.6 \text{ A}/\mu\text{s}$ $t_{v_i} = t_{v_i \text{ max.}}, v_D = 67\% \text{ V}_{DRM}$	(dv/dt) <sub>cr</sub>		1000	V/µs
Killische Spatinungssteineit	childa rate of rise of on-state voltage	tyj = tyj max., VD = 07 90 VDRM	(dv/dt/cr		1000	νημο
Charakteristische Werte	Characteristic values					
Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vi} = t_{vi  max}, i_T = 350  A$	V <sub>T</sub>	max.	1,48	٧
Schleusenspannung	threshold voltage	t <sub>vi</sub> =t <sub>vi max</sub>	V <sub>T(TO)</sub>		0,85	٧
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vi} = t_{vi max}$	r <sub>T</sub>		1,5	$m\Omega$
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vi} = 25^{\circ}C, \ v_D = 6 \text{ V}$	I <sub>GT</sub>	max.	150	mΑ
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vi} = 25^{\circ}C, \ v_D = 6 \text{ V}$	V <sub>GT</sub>	max.	1,4	V
Nicht zündender Steuerstrom	gate non trigger current	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, v_D = 6 \text{ V}$	I <sub>GD</sub>	max.	5	mΑ
Nicht zündende Steuerspannung	gate non trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, v_D = 0.5 V_{DRM}$	V <sub>GD</sub>	max.	0,2	٧
Haltestrom	holding current	$t_{v_j} = 25^{\circ}\text{C}, \ v_D = 6 \text{ V}, \ R_A = 5 \ \Omega$	I <sub>H</sub>	max.	200	mΑ
Einraststrom	latching current	$t_{v_j} = 25^{\circ}\text{C}, \ v_D = 6 \text{ V, R}_{GK} \ge 10 \ \Omega$	IL.	max.	620	mΑ
		$i_{GM} = 0.6 \text{ A, } di_{G}/dt = 0.6 \text{ A/}\mu\text{s, } t_{g} = 20 \mu\text{s}$				
Vorwärts- un <mark>d Rückwä</mark> rts-	forward off-state and	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, v_D = V_{DRM}, v_R = V_{RRM}$	i <sub>D</sub> , i <sub>R</sub>	max.	25	mA
Sperrstrom	reverse currents				7.1	
Zündverzug	gate controlled delay time	$t_{vj} = 25$ °C, $i_{GM} = 0.6$ A, $di_{G}/dt = 0.6$ A/ $\mu$ s	t <sub>gd</sub>	max.	3	μs
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	siehe Techn. Erl./see Techn. Inf.	tq	typ.	180	μs
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	V <sub>ISOL</sub>	-07	3	kV
hermische Eigenschaften	Thermal properties					
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance,	θ = 180°el, sinus: pro Modul/per module	R <sub>thJC</sub>	max.	0,115	C/W
	junction to case	pro Zweig/per arm		max.	0,23	C/W
		DC: pro Modul/per module		max.	0,1079	C/W
	PZSC.CO	pro Zweig/per arm		max.	0,214	C/W
	0750					
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance,	pro Modul/per module	RthCK	max.		
	case to heatsink	pro Zweig/per arm		max.	0,06 °	C/W
Höchstzul. Sperrschichttemperatur	max. junction temperature		t <sub>vj max</sub>			25°C
Betriebstemp <mark>eratur</mark>	operating temperature		t <sub>c op</sub>		°C+1:	
Lagertemperatur	storage temperature		t <sub>stg</sub>	- 40	°C…+1:	30°C
Anchanische Eigenschaften	Mechanical properties					
Mechanische Eigenschaften Si-Elemente mit Druckkontakt	Si-pellets with pressure contact		AL ALL AL			
Innere Isolation	internal insulation					AIN
Anzugsdrehmomente	tightening torques	Ca)/((C)				
mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance ± 15%	M1		6	Nm
elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance + 5%/- 10%	M2			Nm
Gewicht	weight		G		typ. 4	30 g
Kriechstrecke	creepage distance					mm
Schwingfestigkeit	vibration resistance	f = 50 Hz			5 · 9,81	m/s²
Maβbild	outline		1			6

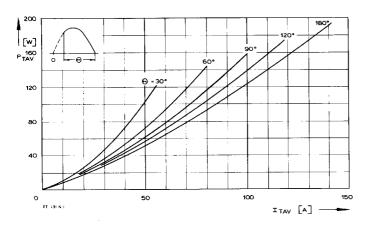
Diese Module können auch mit gemeinsamer Anode oder gemeinsamer Kathode geliefert werden. These modules can also be supplied with common anode or common cathode.



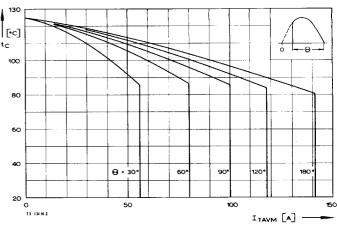


### **EUPEC**

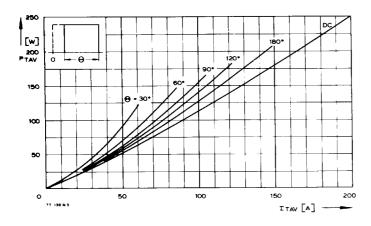
# TT 131 N, TD 131 N, DT 131 N



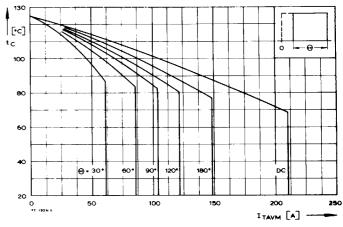
Bild/Fig. 1 Durchla $\theta$ verlustleistung eines Zweiges/On-state power loss per arm  $P_{TAV}$  Parameter: Stromflu $\theta$ winkel/current conduction angle  $\theta$ 



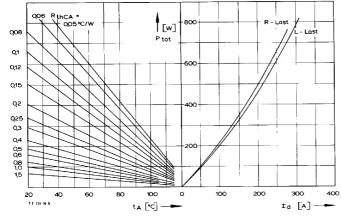
Bild/Fig. 2 Höchstzulässige Gehäusetemperatur  $t_{\text{C}}$  in Abhängigkeit vom Zweigstrom Maximum allowable case temperature  $t_{\text{C}}$  versus current per arm



Bild/Fig. 3 Durchlaßverlustleistung eines Zweiges/On-state power loss per arm  $P_{TAV}$  Parameter: Stromflußwinkel/current conduction angle  $\Theta$ 

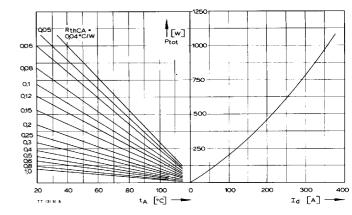


Bild/Fig. 4 Höchstzulässige Gehäusetemperatur t<sub>C</sub> in Abhängigkeit vom Zweigstrom Maximum allowable case temperature t<sub>C</sub> versus current per arm



Bild/Fig. 5 B2 – Zweipuls-Brückenschaltung/Two-pulse bridge circuit Höchstzulässiger Ausgangsstrom I<sub>d</sub> in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur t<sub>a</sub>.

Maximum allowable output current  $I_d$  versus ambient temperature  $t_A$ . Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/thermal resistance case to ambient  $R_{thCA}$ 



Bild/Fig. 6

B6 – Sechspuls-Brückenschaltung/Six-pulse bridge circuit

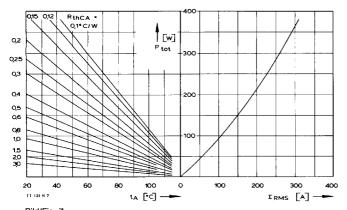
Höchstzulässiger Ausgangsstrom I<sub>d</sub> in Abhängigkeit von der Umgebungs
temperatur t<sub>A</sub>.

Maximum allowable output current I<sub>d</sub> versus ambient temperature t<sub>A</sub>.

Maximum allowable output current I<sub>d</sub> versus ambient temperature t<sub>A</sub>. Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/thermal resistance case to ambient R<sub>thCA</sub>

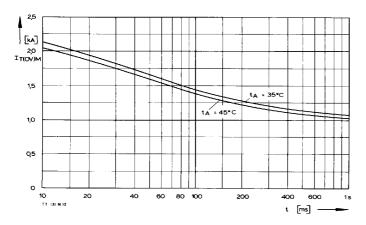
### 61E D 3403297 0001100 3T8 WUPEC

# TT 131 N, TD 131 N, DT 131 N



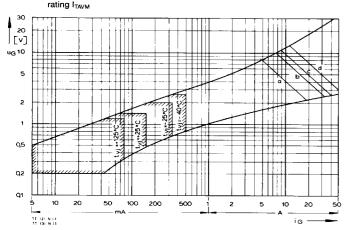
Bild/Fig. 7
W1C – Einphasen-Wechselwegschaltung/Single-phase inverse parallel circuit
Höchstzulässiger Strom I<sub>RMS</sub> in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur t<sub>A</sub>.
Maximum allowable current I<sub>RMS</sub> versus ambient temperature t<sub>A</sub>.

Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/ thermal resistance case to ambient  $\mathbf{R}_{\text{thCA}}$ 



Bild/Fig. 9 Grenzstrom je Zweig I $_{T(OV)M}$  bei Luftselbstkühlung,  $t_A=45^{\circ}C$  und verstärkter Luftkühlung,  $t_A=35^{\circ}C$ , Kühlkörper KP0,33S,  $v_{RM}=0.8$  V $_{RRM}$ . Limiting overload on-state current per arm I $_{T(OV)M}$  at natural ( $t_A=45^{\circ}C$ ) and forced ( $t_A=35^{\circ}C$ ) cooling, heatsink type KP0.33S,  $v_{RM}=0.8$  V $_{RRM}$ . a – Belastung nach Leerlauf/current surge under no-load conditions

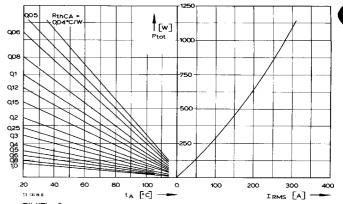
b – Belastung nach Betrieb mit Dauergrenzstrom I<sub>TAVM</sub>
Current surge occurs during operation at limiting mean on-state current



Bild/Fig. 11 Zündbereich und Spitzensteuerleistung bei  $v_D=6\ V.$ 

Gate characteristic and peak gate power dissipation at  $v_0 = 6 \text{ V}$ .

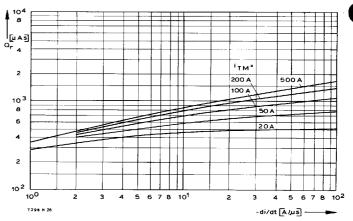
The state of the s						
Parameter:			b	С	d	
Steuerimpulsdauer/Pulse duration t <sub>g</sub>	[ms]	10	1	0,5	0,1	
Höchstzulässige Spitzensteuerleistung/						
Maximum allowable peak gate power	[W]	40	80	100	150	



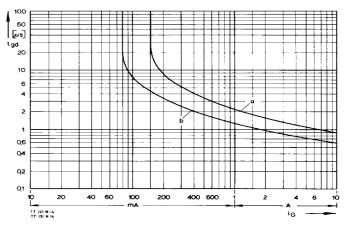
Bild/Fig. 8 W3C – Dreiphasen-Wechselwegschaltung/Three-phase inverse parallel circuit Höchstzulässiger Strom je Phase I<sub>RMS</sub> in Abhängigkeit von der Umgebungs-

Maximum allowable current per phase I<sub>RMS</sub> versus ambient temperature t<sub>A</sub>.

Parameter: Wärmewiderstand zwischen Powerblock und Umgebung/
thermal resistance case to ambient R<sub>IbCA</sub>



Bild/Fig. 10 Sperrverzögerungsladung  $Q_r$  in Abhängigkeit von der abkommutierenden Stromsteilheit -di/dt bei  $t_{ij} = t_{ij}$   $_{max}$ ,  $V_R = 0.5$   $V_{RRM}$ ,  $V_{RM} = 0.8$   $V_{RRM}$ . Der angegebene Verlauf ist gültig für 90% aller Elemente. Recovered charge versus the rate of decay of the forward on-state current -di/dt at  $t_{ij} = t_{ij}$   $_{max}$ ,  $V_R = 0.5$   $V_{RRM}$ ,  $V_{RRM} = 0.8$   $V_{RRM}$ . These curves are valid for 90% of all devices. Parameter: Durchlaßstrom  $i_{TM}/On$ -state current  $i_{TM}$ 



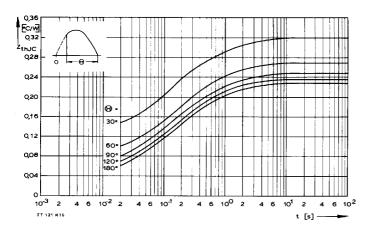
Bild/Fig. 12 Zündverzug/Gate controlled delay time  $t_{gd}$ , DIN 41787,  $t_a=1~\mu s$ ,  $t_{vj}=25^{\circ}C$ . a – äußerster Verlaut/limiting characteristic

b - typischer Verlauf/typical characteristic

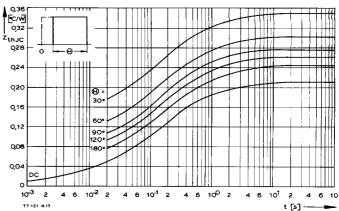
### **EUPEC**

## 6%E D 3403297 000%10% 234 MUPEC

## TT 131 N, TD 131 N, DT 131 N



Bild/Fig. 13 Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig  $Z_{\text{(th)JC}}$ . Transient thermal impedance per arm  $Z_{\text{(th)JC}}$ , junction to case.



Bild/Fig. 14
Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig Z<sub>(th)JC</sub>.
Transient thermal impedance, junction to case, per arm Z<sub>(th)JC</sub>.

Pos. n	1	2	3	4	5
R <sub>thn</sub> [°C/W]	0,00956	0,025	0,0763	0,0726	0,0305
τ <sub>n</sub> [s]	0,00089	0,0078	0,086	0,421	245

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1-e^{t/\tau_n})$$

Transienter Wärmewiderstand  $Z_{\text{thJC}}$  pro Zweig für DC. Transient thermal impedance  $Z_{\text{thJC}}$  per arm for DC.